

## КТ872

п-р-п кремниевый  
эпитаксиально-планарный  
высоковольтный транзистор

### Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы (КТ872Г с демпфирующим диодом). Предназначены для применения в блоках питания, в схемах строчной развертки телевизионных приемников, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

### Зарубежные прототипы

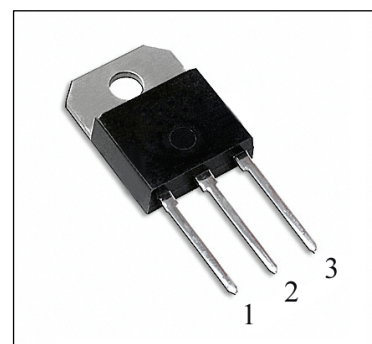
- Прототипы – BU508A, BU508, BU508D

### Особенности

- Диапазон рабочих температур от - 60 до + 125°С

### Обозначение технических условий

- аАО.336.681 ТУ / 02



### Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-43 (ТО-218) - КТ872А, Б, В, Г
- пластмассовый корпус КТ-43 ISOWATT (ТО-218 ISOWATT) - КТ872А1, Г1

### Назначение выводов

| Вывод | Назначение |
|-------|------------|
| №1    | База       |
| №2    | Коллектор  |
| №3    | Эмиттер    |

**Таблица 1. Основные электрические параметры КТ872 при  $T_{\text{окр. среды}} = 25^\circ\text{C}$**

| Параметры                                                                                            | Обозн.   | Ед. изм | Режимы измерения                                                             | Min        | Max                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Граничное напряжение коллектор-эмиттер<br>КТ872А, Б, Г, А1, Г1<br>КТ872В                             | Укэо гр. | В       | Ik=100mA, Ib=0,<br>L=40мГн                                                   | 700<br>600 |                          |
| Обратный ток коллектора<br>КТ872А, Б, Г, А1, Г1<br>КТ872В                                            | Ikэк     | мА      | Укэк =1500В Ubэ=0<br>Укэк =1200В Ubэ=0                                       |            | 1,0<br>0,6               |
| Обратный ток эмиттера<br>КТ872А, Б, В, А1<br>КТ872Г, Г1                                              | Iэбо     | мА      | Uэб=6В                                                                       | 75         | 10<br>150                |
| Статический коэффициент передачи тока<br>КТ872В                                                      | h21э     |         | Укэ=5В, Ik=0,03А                                                             | 6          |                          |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер<br>КТ872А, Г, А1, Г1<br>КТ872А, Г, А1, Г1<br>КТ872Б<br>КТ872В | Укэ(нас) | В       | Ik=2,5А, Ib=0,6А<br>Ik=4,5А, Ib=2,0А<br>Ik=4,5А, Ib=2,0А<br>Ik=2,5А, Ib=1,0А |            | 0,5<br>1,0<br>5,0<br>1,0 |
| Время спада<br>КТ872А, Г, А1, Г1<br>КТ872Б, В                                                        | tсп.     | мкс     | Укэ=500В,<br>Ik нас =4,5А                                                    |            | 0,8<br>1,0               |
| Время рассасывания<br>КТ872А, Г, А1, Г1<br>КТ872Б, В                                                 | трас.    |         | Iб нас= Ib зап =1,4 А<br>Ubэ зап = -5В                                       |            | 6,7<br>7,5               |
| Постоянное прямое напряжение диода<br>КТ872Г, Г1                                                     | Uпр.     | В       | Iпр=4,5А                                                                     |            | 2,0                      |

**Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ872**

| Параметры                                                                                                 | Обозначение   | Ед. измер. | Значение     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Напряжение коллектор-эмиттер:<br>КТ872А, Б, Г, А1, Г1<br>КТ872В                                           | Укэо max      | В          | 700<br>600   |
| Напряжение коллектор-эмиттер (импульсное):<br>Ubэ ≤0В, Q ≥4, tu ≤20 мкс<br>КТ872А, Б, Г, А1, Г1<br>КТ872В | Укэ и max     | В          | 1500<br>1200 |
| Напряжение эмиттер-база                                                                                   | Uэб max       | В          | 6            |
| Постоянный ток коллектора                                                                                 | Ik max        | А          | 8            |
| Импульсный ток коллектора                                                                                 | Iki max       | А          | 15           |
| Постоянный ток базы                                                                                       | Iб max        | А          | 4            |
| Импульсный ток базы                                                                                       | Iби max       | А          | 6            |
| Постоянный запирающий ток базы                                                                            | Iб зап. max   | мА         | 100          |
| Импульсный запирающий ток базы                                                                            | Iб зап. и max | А          | 5            |
| Рассеиваемая мощность коллектора:<br>КТ872А, Б, В, Г<br>КТ872А1, Г1                                       | Рк max        | Вт         | 100<br>34    |
| Температура перехода                                                                                      | Tj            | °C         | 150          |